紧束缚模型怎么建立?

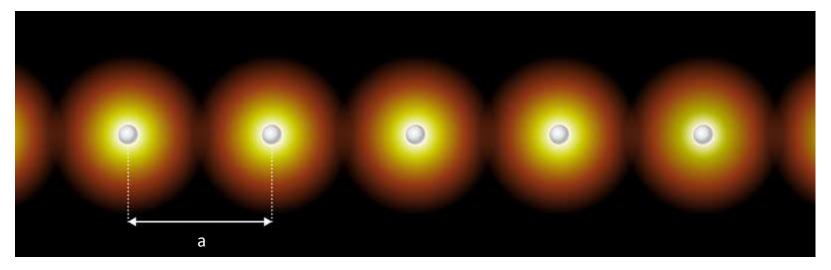
- 以一维氢晶体为例
 - 1. 列出薛定谔方程
 - 2. 利用原子轨道线性组合,得到波函数,近似满足薛定谔方程
 - 3. 求其平均能量,是波矢的函数
 - 4. 求群速度
 - 5. 列出运动方程,即可求解

薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = -i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} \qquad V = \sum_{\pmb{R}} -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\pmb{x}-\pmb{R}|}$$
 即 $\hat{H}\psi = \hat{E}\psi$ R取遍所有正格矢

紧束缚模型下的一维氢晶体

$$\psi_{1s}(x+2a) \quad \psi_{1s}(x+a) \qquad \psi_{1s}(x) \qquad \psi_{1s}(x-a) \quad \psi_{1s}(x-2a)$$



总波函数
$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{R} e^{i k \cdot R} \psi_{1s}(x - R)$$
 R取遍所有正格矢 归一化系数 原子轨道 "波形"式线性组合

$$k=rac{2m\pi}{Na}$$
 $m=-rac{N}{2}+1,...,rac{N}{2}$ 为布里渊区(- π /a, π /a]均分成N份

波函数的性质

概率密度的平移不变性

$$\psi(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \psi_{1s}(\mathbf{x} - \mathbf{R})$$

对任意正格矢R'

$$\psi(\mathbf{x} + \mathbf{R}') = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \psi_{1s}(\mathbf{x} - (\mathbf{R} - \mathbf{R}'))$$

$$= e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}'} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{R}''} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}''} \psi_{1s}(\mathbf{x} - \mathbf{R}'')$$

$$\mathbf{R}'' = \mathbf{R} - \mathbf{R}'$$
取遍所有正格矢
$$= e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}'} \psi(\mathbf{x}) \qquad k = \frac{2m\pi}{Na} \quad m = -\frac{N}{2} + 1, \dots, \frac{N}{2}$$

因此, $\psi(x)$ 的概率密度在平移后不变

其中用到了周期性边界条件

波函数的性质

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{R} e^{i\mathbf{k}\cdot R} \psi_{1S}(x - R)$$

$$= e^{i\mathbf{k}\cdot x} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{R} e^{i\mathbf{k}\cdot (R - x)} \psi_{1S}(x - R)$$

$$\equiv e^{i\mathbf{k}\cdot x} u(x) \qquad \text{称为布洛赫(Bloch) 波}$$
对任意正格矢R'

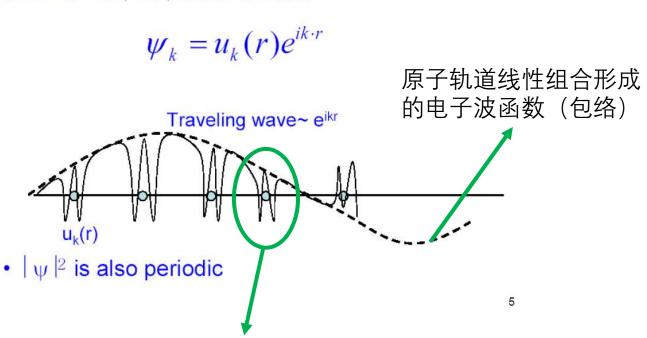
$$u(x)$$
满足
$$u(x + R') = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{R} e^{ik \cdot ((R - R') - x)} \psi_{1s}(x - (R - R'))$$
$$= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{R''} e^{ik \cdot (R'' - x)} \psi_{1s}(x - R'')$$
$$= u(x)$$

 $\psi(x) = e^{ik \cdot x} u(x)$, u(x)有晶格的周期性,称为<u>布洛赫定理</u>

布洛赫定理的理解

The periodic potential function in a single crystal material

 In periodic potential, an electron will behave in this manner, i.e., Bloch electron



原子轨道/原子波函数

紧束缚模型怎么建立?

- 以一维氢晶体为例
 - 1. 列出薛定谔方程
 - 2. 利用原子轨道线性组合,得到波函数,近似满足薛定谔方程
 - 3. 求其平均能量,是波矢的函数
 - 4. 求群速度
 - 5. 列出运动方程,即可求解

波函数的能量

平均能量

波函数的能量

平均能量

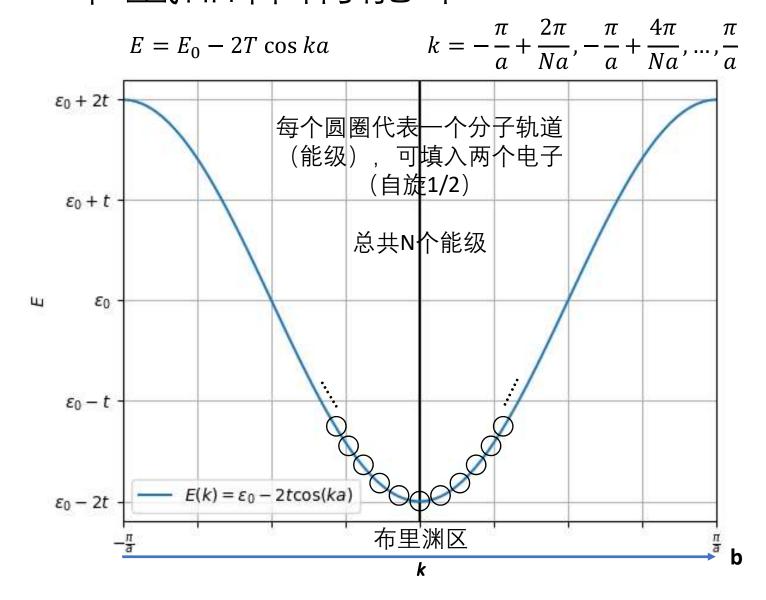
$$\int \psi(\mathbf{x}, t)^* \widehat{E} \psi(\mathbf{x}, t) dV = \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \int \psi_{1s}(\mathbf{x})^* \widehat{H} \psi_{1s}(\mathbf{x} - \mathbf{R}) dV$$
$$= E_{1s} - Te^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} - Te^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}}$$
$$= E_{1s} - 2T\cos ka$$

一维氢晶体的能带(紧束缚模型)

$$\underline{E(k)} = \underline{E_{1s}} - 2T\cos ka$$
 $k = \frac{2m\pi}{Na}$ $m = -\frac{N}{2} + 1, ..., \frac{N}{2}$

即能量-波矢关系

一维氢晶体的能带



波函数的性质

波函数关于倒格矢的平移不变性

$$\psi(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \psi_{1s}(\mathbf{x} - \mathbf{R})$$

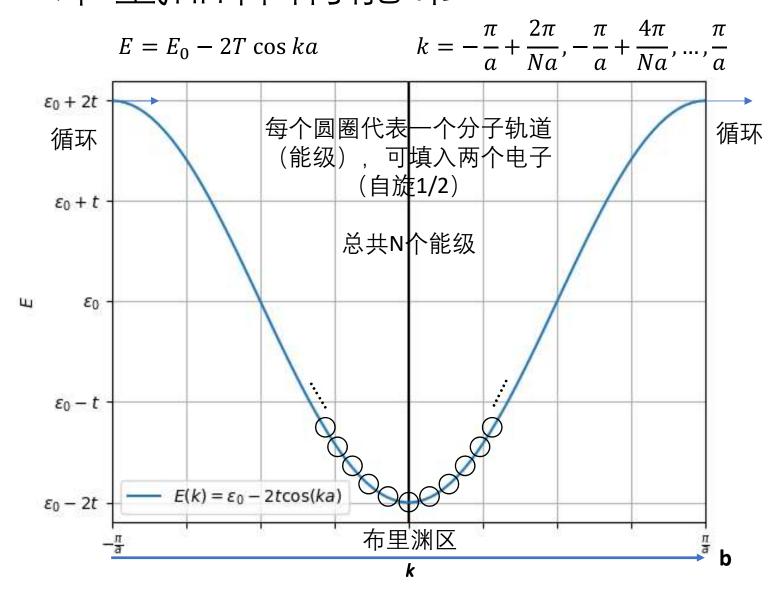
$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{R}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{R}} \psi_{1s}(\mathbf{x} - \mathbf{R}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} e^{i\mathbf{b}\cdot\mathbf{R}} \psi_{1s}(\mathbf{x} - \mathbf{R})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \psi_{1s}(\mathbf{x} - \mathbf{R})$$

$$(\mathbf{b} \cdot \mathbf{R} = \mathbf{b} \cdot n\mathbf{a} = 2n\pi)$$

因此,k在经过任意倒格矢平移之后波函数不变

一维氢晶体的能带



紧束缚模型怎么建立?

- 以一维氢晶体为例
 - 1. 列出薛定谔方程
 - 2. 利用原子轨道线性组合,得到波函数,近似满足薛定谔方程
 - 3. 求其平均能量,是波矢的函数
 - 4. 求群速度
 - 5. 列出运动方程,即可求解

群速度和准经典近似

- 波包群速度是 $\frac{d\omega}{d\mathbf{k}}$
 - $E(k) = \hbar\omega \sim E_{1s} 2T\cos ka$ $v = \frac{d\omega}{dk} \sim \frac{2Ta}{\hbar}\sin ka$
- 将电子置于力场F中

在dt时间后,力冲量为Fdt 但动量有良好定义吗? Fdt ? dp ? $\hbar dk$

晶体波函数的严格解

薛定谔方程
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = -i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

$$V = \sum_{R} -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |x - R|}$$

可证明,波函数也具有布洛赫波形式 $\psi = e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)}u(\mathbf{x})$

$$u(\mathbf{x})$$
满足 $u(\mathbf{x} + \mathbf{R}) = u(\mathbf{x})$

其中R为任意正格矢

$$E(k) \sim E_{1s} - 2T\cos ka$$
 $k = \frac{2m\pi}{Na}$ $m = -\frac{N}{2} + 1, ..., \frac{N}{2}$

能量和动量

- $\psi = e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} \omega t)}u(\mathbf{x})$ 是能量本征态, $E = \hbar\omega$
- 紧束缚模型中 ψ 并非能量本征态,只有平均能量
 - 但近似为能量本征态
 - 求解薛定谔方程得到的能量本征态和紧束缚模型差别 不大
- $\psi = e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} \omega t)}u(\mathbf{x})$ 是动量本征态吗?
 - $\hat{p}\psi = -i\hbar\nabla\psi = \hbar k\psi + \frac{\nabla u(x)}{u(x)}\psi$
 - 但ħ**k**表现出了某些动量的性质,称为<u>准动量</u>(或<u>晶</u> 格动量)
 - 因为群速度是 $d\omega/dk$

紧束缚模型怎么建立?

- 以一维氢晶体为例
 - 1. 列出薛定谔方程
 - 2. 利用原子轨道线性组合,得到波函数,近似满足薛定谔方程
 - 3. 求其平均能量,是波矢的函数
 - 4. 求群速度
 - 5. 列出运动方程,即可求解

群速度和准经典近似

- 波包群速度是 $\frac{d\omega}{d\mathbf{k}}$
 - $E(k) = \hbar\omega \sim E_{1s} 2T\cos ka$ $v = \frac{d\omega}{dk} \sim \frac{2Ta}{\hbar}\sin ka$
- 将电子置于力场F中

在dt时间后,力冲量为Fdt 但动量没有良好定义 Fdt ? dp ? $\hbar dk$ 经过dx距离,力做功为Fdx

$$Fvdt = Fdx = dE = \hbar d\omega = \hbar dk \frac{d\omega}{dk} = \hbar vdk$$

因此还是有 $F = \frac{\hbar dk}{dt}$

$$\mathbf{F} = \frac{\hbar d\mathbf{k}}{dt}$$
 其实也正确,可用传播子理论证明(略)

三种模型中的电子

自由电子
$$\psi = \psi_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$
 $(\frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} = \hbar \omega)$

含有波矢量,可以传播,是非束缚态能量 $\hbar\omega$ 和动量 $\hbar k$ 是连续的

氢原子中电子
$$\psi = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\phi)e^{-i\omega t}$$
 $(\hbar\omega = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2n^2})$

不含波矢量,不能传播,是束缚态 含有角频率,具有能量ħω,没有动量 能量ħω是不连续的(量子化的)

一维氢原子晶
体能带中电子
$$\psi = e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)}u(\mathbf{x})$$

$$E(k) \sim E_{1s} - 2T\cos ka$$

含有波矢量,可以传播,是非束缚态能量和ħ**k**是不连续的(量子化的)

能带的不连续性

能带的能量、波矢分立但靠得很近: 准连续

波矢之间的间距: $\Delta k = \frac{2\pi}{Na}$ a为纳米级,Na为厘米级

能量之间的间距: $\Delta E = \frac{dE}{dk} \Delta k < 2Ta \frac{2\pi}{Na} = \frac{4\pi T}{N}$ 约10-6eV量级

(T为键能, eV量级)

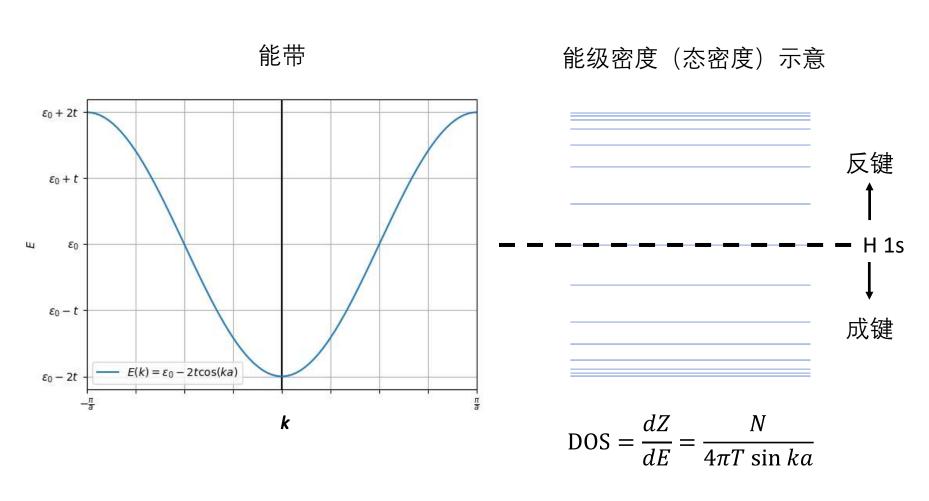
单位k值中波函数(电子态)的数目: $\frac{dZ}{dk} = \frac{1}{\Delta k} = \frac{Na}{2\pi}$

单位能量中波函数(电子态)的数目:态密度(状态密度、能态密度、Density of States/DOS)

 $DOS = \frac{dZ}{dE} = \frac{dZ}{dk}\frac{dk}{dE} = \frac{Na}{2\pi}\frac{1}{2Ta\sin ka} = \frac{N}{4\pi T\sin ka}$ 应写为E的函数, 表达式是什么?

没有考虑自旋,考虑自旋则乘以2

态密度



能带其实就是共价键的成键和反键轨道

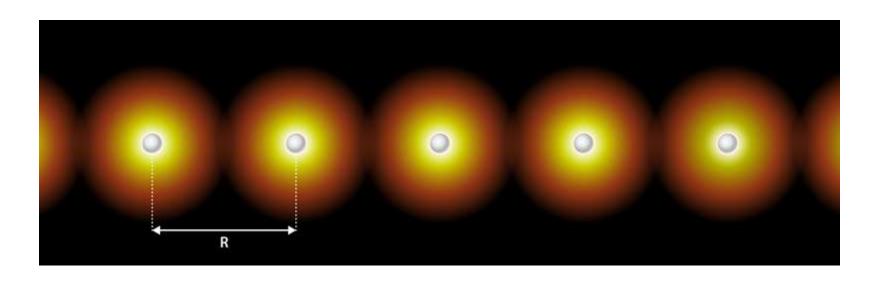
晶体中的共价键是什么?

- 共价键(covalent bond): 由共用电子对对原子 产生作用的机制
- 共价键就是晶体的电子波函数
- 每个共价键中有自旋相反的一对电子
 - 可分为成键和反键两种: 成键能量降低, 反键能量提高(非键通常不算共价键)
- 共价键不是局域的棒状结构

共价键不是局域的棒状结构

- 共价键的位置通常无法良好定义
 - 不确定原理
 - 并不是"没有位置",只是"无法定义":用波函数 (wave function) ψ 描述, $\psi^*\psi$ 为概率密度
- 共价键具有波矢k, 可以向前传播
- 共价键具有能量E, 对应能带结构

共价键的局域和离域



化学中的常见共价键: H-H之间两两连接(局域)

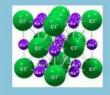


共价键的实质:分子轨道(完全离域),是一组分布于晶体上的波函数 共价键的能量对应能带结构

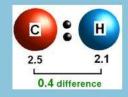
原子之间的作用: 化学键

TYPES OF CHEMICAL BONDS

Ionic bonds



Covalent bonds



Metallic bonds



离子键:库仑力

共价键:价电子 "共有化运动"

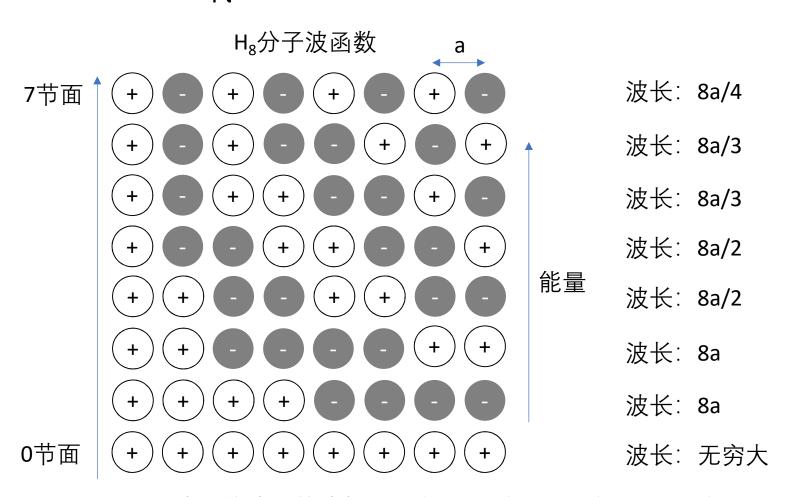
金属键: 价电子"共 有化运动", 可传播 本质就是共价键

共价键也对应了能 带结构

小结: 分子轨道理论

- 分子波函数为相应原子波函数的线性组合
 - $\psi = \alpha_1 \psi_1 + \alpha_2 \psi_2 + \cdots + \alpha_N \psi_N$
- 这些线性组合中,平均能量最低的态为大致的分子波函数(因为电子基态的能量最低)
 - $\int \psi^* \hat{E} \psi dV$ 取极小值
 - 与该分子波函数正交的其它态中,能量最低的态也为大致的分子波函数(因为电子第一激发态的能量次低)
 - 以此类推
- 线性组合前后波函数数目守恒
 - ψ_1 、 ψ_2 、 ...、 ψ_N 会组合出N个分子波函数

链状Hn的分子波函数的"波长"



H₈体系的波函数波长为无穷大、2个8a、2个8a/2、2个8a/3、2a

对应的波矢k = 0、 $\pm 2\pi/8a$ 、 $\pm 4\pi/8a$ 、 $\pm 6\pi/8a$ 、 $8\pi/8a$ 为布里渊区 $(-\pi/a, \pi/a)$ 均分成N份

紧束缚模型怎么建立?

$$\widehat{H}\psi = \widehat{E}\psi$$

• 以一维氢晶体为例
$$\hat{H}\psi = \hat{E}\psi$$
 • 1. 列薛定谔方程 $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$ $V = \sum_{R} -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|x-R|}$

$$V = \sum_{R} -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{x} - \mathbf{R}|}$$

• 2. 利用原子轨道线性组合, 得到波函数, 近似满足薛 定谔方程

"波形"式线性组合

$$k = \frac{2m\pi}{Na}$$

$$m = -\frac{N}{2} + 1, \dots, \frac{N}{2}$$

• 3. 求其平均能量

$$\int \psi(\mathbf{x},t)^* \hat{E} \psi(\mathbf{x},t) dV \sim \int \psi(\mathbf{x})^* \hat{H} \psi(\mathbf{x}) dV \qquad (\hat{H} \psi \sim \hat{E} \psi)$$

紧束缚模型怎么建立?

- 以一维氢晶体为例
 - 3. 求其平均能量,是波矢的函数

$$\int \psi(\mathbf{x}, t)^* \widehat{E} \psi(\mathbf{x}, t) dV \sim \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \int \psi_{1s}(\mathbf{x})^* \widehat{H} \psi_{1s}(\mathbf{x} - \mathbf{R}) dV$$
$$= E_{1s} - Te^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} - Te^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}}$$
$$= E_{1s} - 2T\cos ka$$

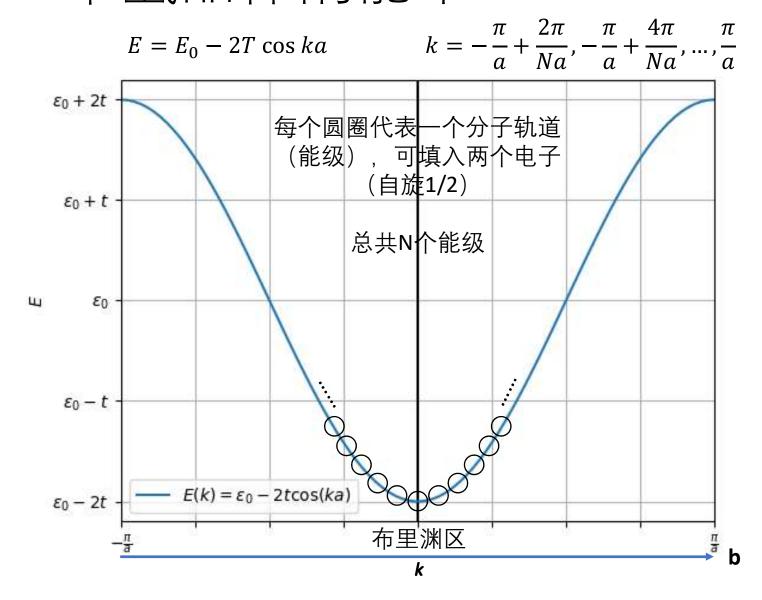
• 4. 求群速度

$$v = \frac{d\omega}{dk} \sim \frac{2Ta}{\hbar} \sin ka$$

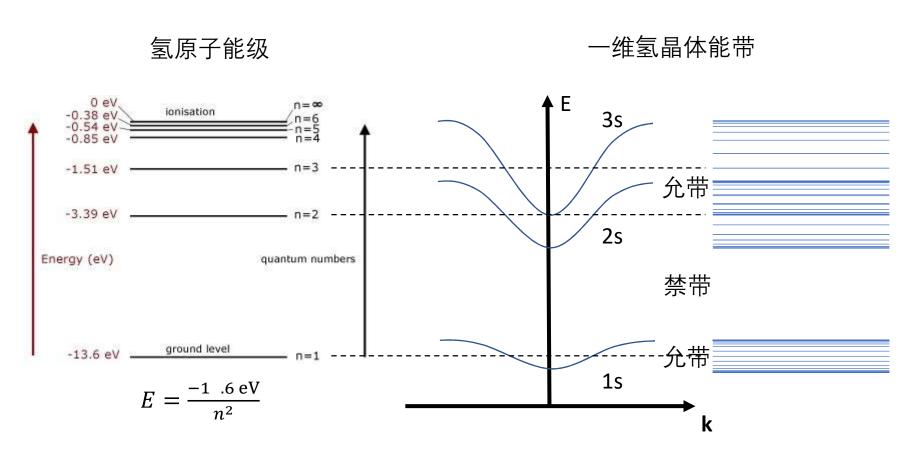
• 5. 列出运动方程,即可求解

$$\boldsymbol{F} = \frac{\hbar d\boldsymbol{k}}{dt}$$

一维氢晶体的能带



原子能级的展宽构成能带



原子波函数线性组合→晶体波函数(布洛赫波) 原子能级→晶体能带(在原子能级上下展宽)

小结:一维氢晶体的能带理论

- 分子中的共价键推广到晶体: 能带
 - 能级劈裂→能带展宽(波函数重叠越大,展宽越宽)
 - 成键轨道→能带低于原子能级的部分;反键轨道→能带高于原子能级的部分
- 晶体的能带具有波矢k, 能传播
 - 横轴为倒空间坐标, 布里渊区
 - 近似由原子中价电子波函数的线性组合形成
- 1s紧束缚模型的结果(s轨道)

$$E = E_0 - 2T \cos ka$$
 $k = -\frac{\pi}{a} + \frac{2\pi}{Na}, -\frac{\pi}{a} + \frac{4\pi}{Na}, ..., \frac{\pi}{a}$

• 能带的能量、波矢分立但靠得很近: 准连续

小结: 严格求解能带理论

• 薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = -i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} \qquad V = \sum_{\pmb{R}} -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\pmb{x} - \pmb{R}|}$$

• 其解为布洛赫波

$$\psi = e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega)}u(\mathbf{x}) \qquad u(\mathbf{x} + \mathbf{R}) = u(\mathbf{x})$$
$$k = -\frac{\pi}{a} + \frac{2\pi}{Na}, -\frac{\pi}{a} + \frac{4\pi}{Na}, \dots, \frac{\pi}{a}$$

- 能量大致为紧束缚模型的结果 $E = \hbar\omega \sim E_0 2T \cos ka$
- 准动量ħk

第二部分: 能带结构

- 自由电子的状态
- 原子中电子的状态
 - 氢原子模型
 - 多电子原子模型
- 晶体中电子的状态
 - 化学键
 - 共价键在晶体中的推广与紧束缚模型
- 绝缘体、半导体、导体的区别

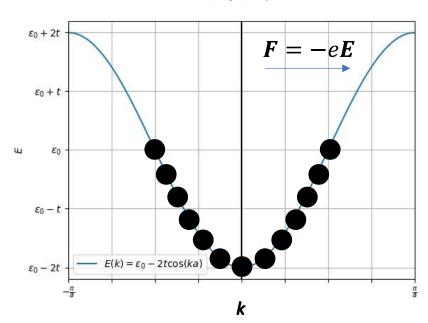
电子的填充

- 从低能量到高能量依次填充
- 每一个能级填充两个电子(自旋1/2)
- H_N晶体: N个H 1s轨道 = N个能级
 - H有1个电子, 总共N个电子
 - 填充到哪里?

能带中电子在电场中的运动

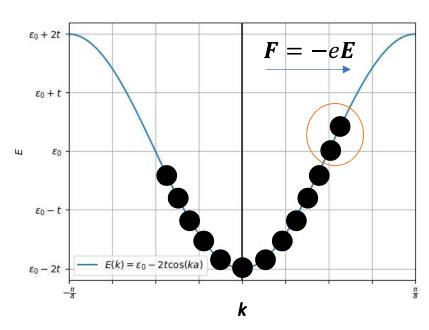
 $Fdt = \hbar dk$ t时间后,所有电子向F方向平移 $k = F\tau/\hbar$

电子已填充部分能带



全部速度抵消,净电流为零

电场作用后电子整体平移

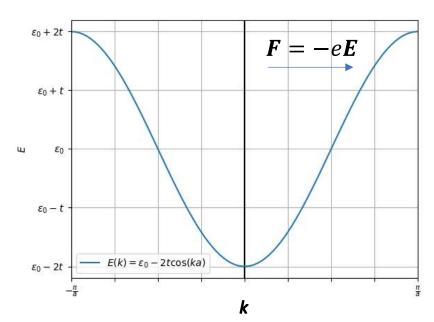


不对称部分提供净电流

能带部分填充-导体

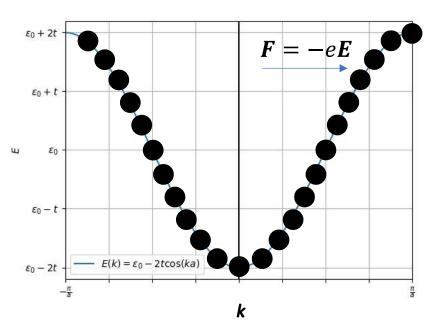
电子填充,导体与非导体

电子不填充能带



没有电子, 无法整体平移

电子填充满能带

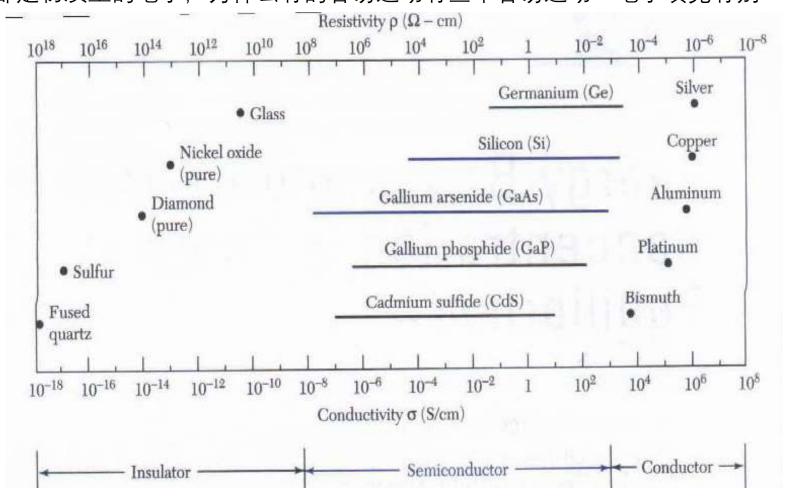


整体平移后仍然充满,全部 速度抵消,净电流为零

能带全满或全空-非导体

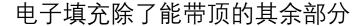
导体、半导体、绝缘体的区别

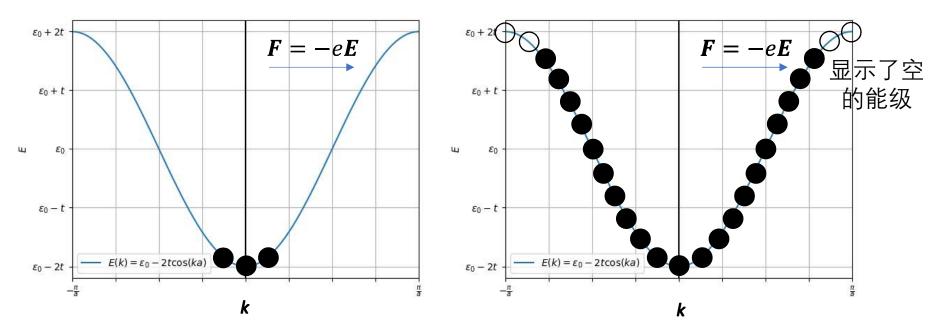
都是物质里的电子,为什么有的容易运动有些不容易运动? 电子填充有别



电子填充, 半导体大部分情况

电子填充能带底



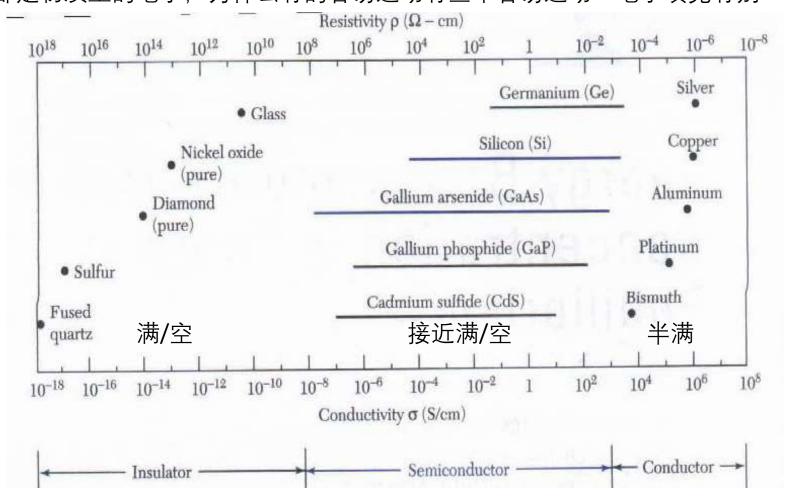


能带边缘的性质对半导体特别重要

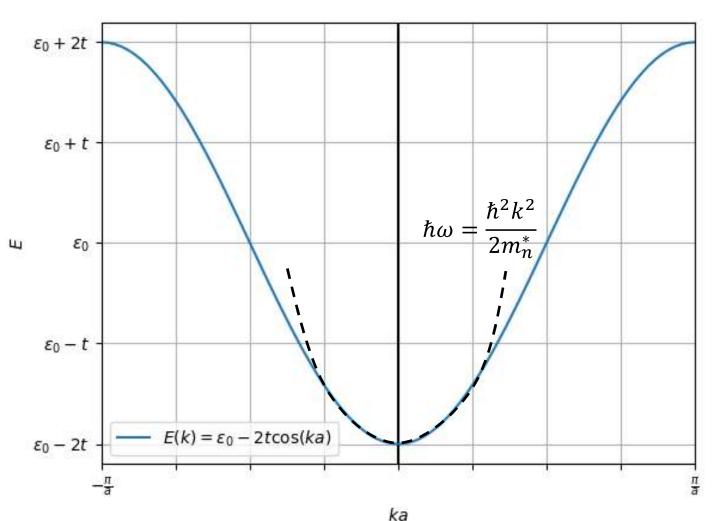
本课程大部分情况下讨论能带边缘的性质

导体、半导体、绝缘体的区别

都是物质里的电子,为什么有的容易运动有些不容易运动? 电子填充有别



能带边缘的近自由电子近似



泰勒展开

 $\hbar\omega \sim E_0 - 2T \cos ka$ $= E_0 - 2T + T(ka)^2$ $+ O(k^4)$

$$\Leftrightarrow Ta^2 = \frac{\hbar^2}{2m_n^*}$$

$$\hbar\omega \sim \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*} + 常数$$

在能带边缘,电子能量接近自由电子,只不过"质量"不同

$$m_n^*$$

称为有效质量;其 越大,说明能带越 平坦

能带边缘电子的速度

能带中电子的速度也是波函数的群速度

波的群速度
$$v=rac{d\omega}{dk}$$
 即能帶斜率
$$\hbar\omega\simrac{\hbar^2k^2}{2m_n^*}$$
 因此 $v\simrac{\hbar k}{m_n^*}$

在能带边缘,电子的速度和自由电子的速度 $v = \frac{\hbar k}{m}$ 形式类似

差别在于用有效质量 m_n^* 替代了真实质量 m_n^*

能带边缘电子的运动

将电子置于力场F中

前文已得
$$Fdt = \hbar d\mathbf{k}$$

由于
$$v \sim \frac{\hbar k}{m_n^*}$$

因此
$$F \sim m_n^* \frac{dv}{dt}$$

和经典牛顿第二定律 F = ma 很相似 差别在于用有效质量 m_n^* 替代了真实质量m

能带边缘电子的态密度

单位k值中波函数(电子态)的数目: $\frac{dZ}{dk} = \frac{1}{\Delta k} = \frac{Na}{2\pi}$

单位能量中波函数(电子态)的数目: 态密度(状态密度、能态密度、Density of States/DOS)

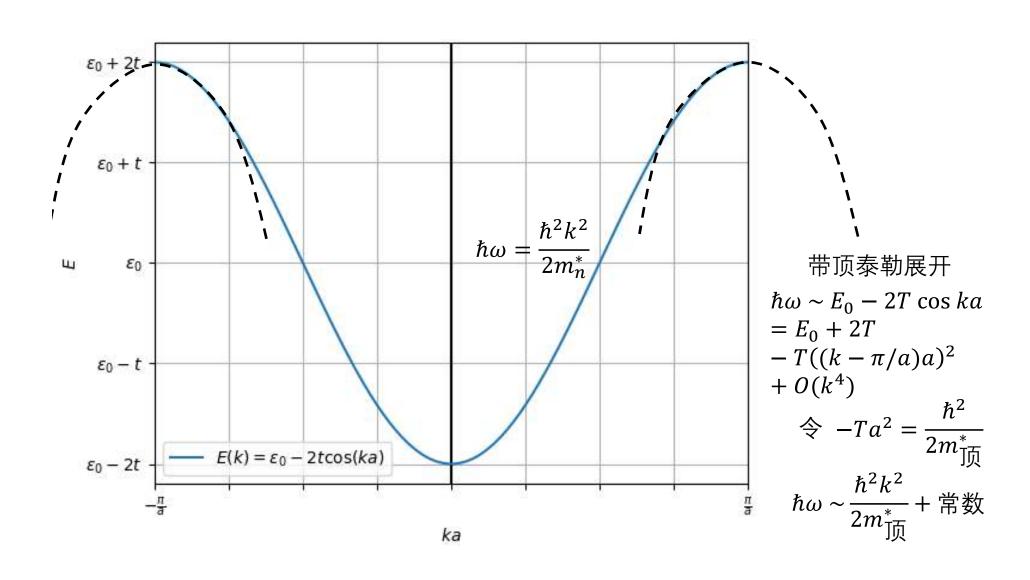
$$DOS = \frac{dZ}{dE} = \frac{dZ}{dk}\frac{dk}{dE} = \frac{Na}{2\pi}\frac{1}{2Ta\sin ka} = \frac{N}{4\pi T\sin ka}$$
 应写为E的函数, 表达式是什么?

没有考虑自旋, 考虑自旋则乘以2

在能带边缘,
$$E \sim \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*} +$$
常数 $\frac{dE}{dk} \sim \frac{\hbar^2 k}{m_n^*}$

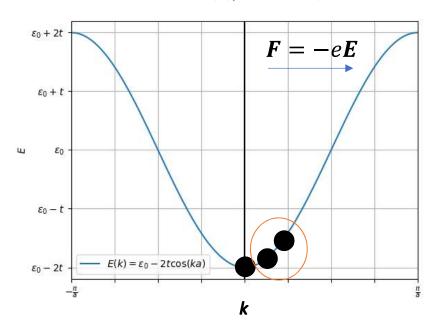
态密度
$$DOS = \frac{dZ}{dE} = \frac{dZ}{dk} \frac{dk}{dE} \sim \frac{Nam_n^*}{2\pi\hbar^2 k} \sim \frac{Na}{2\pi\hbar} \sqrt{\frac{m_n^*}{2(E - 常数)}}$$

能带边缘的近自由电子近似



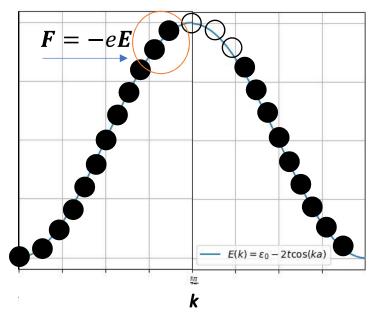
能带上下边缘电子的特性

电子填充能带底



不对称部分提供净电流

电子填充除了能带顶的其余部分



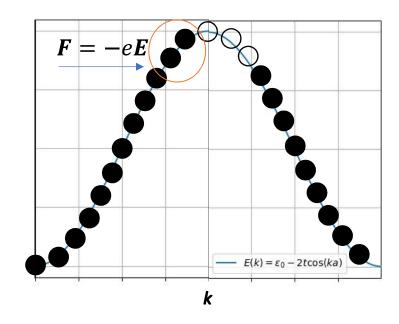
不对称部分提供净电流 能带顶电子有效质量为负值

$$v \sim \frac{\hbar(k - \pi/a)}{m_{\downarrow \bar{\uparrow}}^*}$$

电场负值, 总电子速度为正值, 总电流为负值

空穴

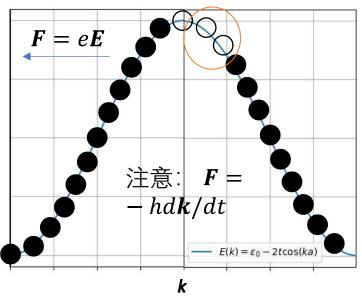
电子填充除了能带顶的其余部分



电子的不对称部分提供净电流 能带顶电子有效质量为负值

$$v \sim rac{\hbar(k-\pi/a)}{m_{ ext{1} inder}^*}$$

带正电的假想粒子"空穴"填充能带顶



空穴的不对称部分提供净电流 此时电子对电流没有贡献 能带顶空穴有效质量m*_p=-m_顶*

$$v \sim \frac{\hbar(k - \pi/a)}{m_p^*}$$
 和电子相反

电场负值, 总电子速度为正值, 总电流为负值; 总空穴速度为负值, 总电流为负值

为什么需要引入空穴?

- 半导体中,电子可能会填到接近能带顶
- 此时,在近自由电子近似下,电子有效质量为负值
- 在物理上,粒子不可能有负质量
 - 向前加力,加速度向后
 - 并且直观上非常不好想象
- 因此, 假想/虚拟一个质量为正, 电荷相反(力也相反)的空穴
- 空穴通常标记为p(positive), 电子通常标记为 n(negative)

复习: 自由/原子中电子

- 如何求解电子状态?
 - 1. 解薛定谔方程,得到波函数,同时得到能量-波矢 关系(色散关系):有→2a,无→2b

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + \nabla\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

• 2a. 利用能量-波矢关系, 算得群速度(波包速度):

$$\boldsymbol{v} = \frac{d\omega}{d\boldsymbol{k}}$$

• 3a. 在准经典近似下,利用群速度列出运动方程并求解

复习: 自由/原子中电子

- 如何求解电子状态?
 - 1. 解薛定谔方程,得到波函数,同时得到能量-波矢 关系(色散关系):有→2a,无→2b

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

- 2b. 利用电子能级填充规律填充电子
- 3b. 和光子(电磁波)作用,利用能量守恒求解

能带中电子和电磁波的作用

- 电子和光子可相互作用
- 电子可吸收光子跃迁到能量更高的能带上; 可发射光子跃迁到能量更低的能带上
- 第五章详细讲述

能带理论: 抽象概念和模型

	自由电子	原子中电子	分子中电子	晶体中电子
薛定谔方程中 的势场	V=0	库伦势	多个库伦势	周期性库伦势
解法	计算求解	计算求解	原子轨道线性 组合(或计算)	原子轨道线性 组合(或计算)
解 (波函数)	平面波、波包	束缚态: 1s、 2s、2p	分子轨道:成键、反键	布洛赫波
解(色散关系 E- k)	$E = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m}$	E和量子数有 关,不含 k	E和节面的多少有关,可认为是"驻波"	E-k有较复杂的 关系(能带), 能带边缘可使 用近自由电子 近似,有效质 量m*
在力场中	F = ma	束缚态	束缚态	$F \sim m^* a$
在电磁波中	(散射)	散射、能级跃 迁	散射、能级跃 迁	散射、能级跃 迁

三维立方氢晶体的能带

将紧束缚近似推广到三维立方氢晶体(晶格常数a),依然有

三维立方氢晶体的能带

$$\int \psi(x,t)^* \hat{E} \psi(x,t) dV = E_{1s} - 2T \left(\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a \right)$$

$$\text{\text{\tilde{t}} \psi \text{\tilde{t}} \text{\tilde{t}} \text{\tilde{t}} = E_{1s} - 6T + \frac{\tilde{t}^2 k_x^2}{2m_n^*} + \frac{\tilde{t}^2 k_y^2}{2m_n^*} + \frac{\tilde{t}^2 k_z^2}{2m_n^*} + O(k^4)}$$

$$= E_{1s} - 6T + \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m_n^*} + O(k^4)$$

此时依然有有效质量、空穴等概念

态密度怎么算?

$$\mathbf{k} = (\frac{2m_1\pi}{Na}, \frac{2m_2\pi}{Na}, \frac{2m_3\pi}{Na})$$
 $m_1, m_2, m_3 = -\frac{N}{2} + 1, \dots, \frac{N}{2}$

波矢之间的间距: $\Delta k = \frac{2\pi}{Na}$

k空间中单位体积含有的波函数(电子态)的数目: $\frac{dZ}{dk^3} = \left(\frac{1}{\Delta k}\right)^3 = \left(\frac{Na}{2\pi}\right)^3$ 考虑自旋再乘以2

等能面

$$E = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m^*} +$$
常数 不妨令常数等于 E_c ,即带底能量

对于确定的E,对应的k称为等能面

$$|\mathbf{k}| = \frac{\sqrt{2m^*(E - E_c)}}{\hbar}$$

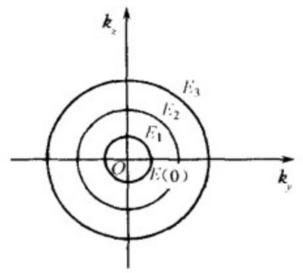


图 1-19 k 空间球形等能面平面示意图

E到E+dE之间可取的波矢有多少个?

三维立方氢晶体的能带

E到E+dE之间可取的波矢有多少个?

E到E+dE之间的体积是等能面的表面积*dk,即 $4\pi k^2 dk$

k空间中单位体积含有
$$\frac{dZ}{dk^3} = 2\left(\frac{Na}{2\pi}\right)^3$$
 个状态(考虑自旋)

因此
$$dZ = 2\left(\frac{Na}{2\pi}\right)^3 4\pi k^2 dk$$

<u>态密度(状态密度、能态密度、Density of States/DOS)</u> 单位能量中波函数(电子态)的数目

DOS =
$$\frac{dZ}{dE} = 2\left(\frac{Na}{2\pi}\right)^3 4\pi \frac{2m^*(E - E_c)}{\hbar^2} \frac{m^*}{\hbar\sqrt{2m^*(E - E_c)}} = \frac{(Na)^3 m^* \sqrt{2m^*(E - E_c)}}{\pi^2 \hbar^3}$$

 $k = |\mathbf{k}| = \frac{\sqrt{2m^*(E - E_c)}}{\hbar} \frac{dE}{dk} = \frac{d}{dk} \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*} = \frac{\hbar^2}{m^*} k = \frac{\hbar\sqrt{2m^*(E - E_c)}}{m^*}$

习题

- 1. (a)硅的布里渊区[111]方向边界叫做L点,求L点的位置。(b)考虑一个自由电子,其波矢量恰好位于L点,求其能量。
- 2. 考虑一个<u>自由电子</u>,要求其波矢量分布(展宽) 小于硅布里渊区大小的千分之一。此时,其位置 的不确定性是多少?

习题

- 3. 试求氢原子Balmer谱线(n>2跃迁到n=2)中红线、蓝线和波长最长的紫线的波长。
- 4. He+离子中1s、2s、2p轨道能量分别各是多少?
- 5. 考虑一维晶体紧束缚模型。H_N、Li_N、Na_N三种晶体中,哪一种能带展宽较大?哪一种能带有效质量较大?说明理由。
- 6. 考虑一维H晶体紧束缚模型。施加外电场**E**, 不考虑散射,一个电子由带顶运动到带底需要多长时间?

习题

- 7. 求二维(简单正方晶格)H晶体紧束缚模型的 能带E(k)和态密度。
- 8. 三维简单立方H晶体(原胞仅含一个原子)晶格常数为0.5 nm,最近邻T = 1 eV。采用紧束缚模型。求:布里渊区大小;能带表达式;带顶/带底有效质量;要求电子波矢量分布(展宽)小于布里渊区大小的千分之一时,电子位置的不确定性。

阅读材料 (非作业)

- 如何利用紧束缚理论计算硅的能带?
- http://materia.fisica.unimi.it/manini/theses/cinqua nta.pdf
- 如果学有余力,不妨学习学习